

プログラム

<午前の部>

9:00 開会の挨拶

一般講演①

座長：高橋和敏（佐賀大）

1. (9:05-9:20)

トポロジカル絶縁体 Bi_2Te_3 の励起電子ダイナミクス

○山本勇^A、小川浩二^A、東純平^A、佐々木実^B、大西彰正^B、北浦守^B、Heon-Jung Kim^C、
今村真幸^A、高橋和敏^A、鎌田雅夫^A

(^A佐賀大シンクロトン光応用セ、^B山形大理、^CDept. Phys., Daegu Univ.)

2. (9:20-9:35)

振動リード法による超伝導試料の内部摩擦測定

○梅本淳、竹下寛紀、孫勇

(九州工業大学先端機能システム工学専攻)

3. (9:35-9:50)

リチウムイオン電池電極活物質の評価に関する研究

○服部勇介^A、境野真道^B、孫勇^A

(^A九州工業大学先端機能システム工学専攻、^B日産自動車株式会社)

4. (9:50-10:05)

$\text{Sc}_3\text{N}@C_{80}$ フラーレン結晶の電気特性評価

○前田祐輝、孫勇（九州工業大学先端機能システム工学専攻）

5. (10:05-10:20)

高密度配向カーボンナノチューブ及びピーポッドの摩擦力測定

○井上一平、吉岡将悟、内藤正路、高原良博、大門秀朗

(九州工業大学大学院)

6. (10:20-10:35)

水素終端ダイヤモンド表面の正孔生成機構: 吸着分子の特定と第一原理計算

○嘉数誠^A、佐藤寿志^B、高木祥光^C、白石賢二^C

(^A佐賀大院、^BNTT物性基礎研、^C筑波大)

10:35-10:45 休憩

一般講演②

座長：大門秀朗（九工大）

7. (10:45-11:00)

ねじれ角で積層した2層グラフェンの幾何学とエネルギー

○三谷尚

(福岡教育大物理教室)

8. (11:00-11:15)

SiC(0001)に成長したグラフェン膜への銅蒸着

○柳生数馬、友景肇、鈴木孝将

(福岡大)

9. (11:15-11:30)

Ni(111)面上に形成したグラフェンのLEEDによる構造解析

○佐々木均、水野清義

(九州大学大学院総合理工学府物質理工学専攻)

10. (11:30-11:45)

Si基板上に成長させたSiC薄膜のグラフェン化に関する研究

○枝元太希^A、内田健太郎^A、岡野資睦^A、内藤正路^A、中尾基^A、碓智徳^B

(^A九州工業大学大学院、^B 宇部工業高等専門学校)

11. (11:45-12:00)

MPCVD法によるダイヤモンド薄膜形成

○中山泰輔^A、森岡明大^B、碓智徳^B、渡邊晃彦^A、内藤正路^A

(^A九州工業大学大学院、^B 宇部工業高等専門学校)

12. (12:00-12:15)

CVD法によるSi基板上へのカーボンナノチューブ形成に関する研究

瀬尾甲太郎^A、竹堂公貴^A、植田謙介^A、内藤正路^A、碓智徳^B

(^A九州工業大学大学院、^B 宇部工業高等専門学校)

12:15- 昼休み

13:00-13:40 施設見学

<午後の部>

特別講演①

座長：東純平（佐賀大）

13. (13:40-14:10)

共有結合性半導体表面における光有機構造変化 - キャリア局在による構造不安定性 -

金崎順一

（大阪大学産業科学研究所）

一般講演③

座長：水野清義（九大）

14. (14:10-14:25)

X線磁気円二色性(XMCD)測定による磁性薄膜の磁化挙動解析

○柳内克昭^A、原晋治^A、平田京^A、島沢幸司^A、野口潔^A、磯上慎二^B、角田匡清^B、高橋研^B、中村哲也^C

（^ATDK株式会社、^B東北大学、^C高輝度光科学研究センター）

15. (14:25-14:40)

超音速分子線によるGe(111)-c(2x8)表面の酸化促進効果

○岡田隆太^{A,B}、吉越章隆^A、寺岡有殿^{A,C}、神農宗徹^{A,C}、山田洋一^B、佐々木正洋^B
（^A原子力機構、^B筑波大数物、^C兵庫県大院物質理学）

16. (14:40-14:55)

環境セル型透過電子顕微鏡用窒化物隔膜の開発

○山崎佳代^A、松谷貴臣^A、川崎忠寛^B

（^A近畿大学、^B名古屋大学）

17. (14:55-15:10)

エチレンプラズマを用いた炭素膜形成過程の赤外分光計測

○高木雄也、八木翔平、高見佳生、津村高成、篠原正典、松田良信、藤山寛
（長崎大学大学院工学研究科）

18. (15:10-15:25)

多重内部反射赤外分光法を用いた液中プラズマの反応計測法の開発

○深江陽大、天野勝裕、篠原正典、松田良信、藤山寛
（長崎大学大学院工学研究科）

15:25-15:35 休憩

特別講演②

座長：今村真幸（佐賀大）

19. (15:35-16:05)

放射光を用いた材料の表面・界面の研究

小林英一

（九州シンクロトロン光研究センター）

一般講演④

座長：篠原正典（長崎大）

20. (16:05-16:20)

STMを用いた変調分光法による貴金属粒子の局所状態密度測定

○尹虎俊、西谷龍介

（九州工業大学工学部）

21. (16:20-16:35)

HWCVD法によるSiCNの立体物上への均一堆積に関する研究

○金光伸友^A、大野悠^A、南條裕介^B、和泉亮^{A,B,C}、門谷豊^C

（^A九州工業大学大学院工学府、^B九州工業大学工学部、^Cトップマコート(株)）

22. (16:35-16:50)

HWCVD法によりSi基板の上に堆積したSiCN膜の硬度及び剥離強度評価

○中上昌俊^A、河島慎吾^A、川原淳樹^A、山田知広^{A,B}、門谷豊^C、和泉亮^{A,C}

（^A九州工業大学大学院工学府、^B九州職業能力開発大学校、^Cトップマコート(株)）

23. (16:50-17:05)

水素ラジカルの輸送に適した輸送管材質の検討

○三谷大星、船越直人、黒木裕也、西山岩男、和泉亮

（九州工業大学大学院）

一般講演⑤

座長：内藤正路（九工大）

24. (17:05-17:20)

アントシアニン系色素を用いた色素増感太陽電池に関する研究

○香川成矢^A、永露友宏^A、柴原幸平^A、福田勇治^B、古川昌司^A

（^A九工大院情報工、^B九工大院生命体工）

25. (17:20-17:35)

酸化物半導体ペーストが色素増感太陽電池の特性に与える影響

○水城達也、柴原幸平、岩本僚太郎、香川成矢、古川昌司

(九工大院情報工)

26. (17:35-17:50)

色素増感太陽電池における酸化物半導体膜の表面処理に関する研究

○岩本僚太郎、永露友宏、水城達也、古川昌司

(九工大院情報工)